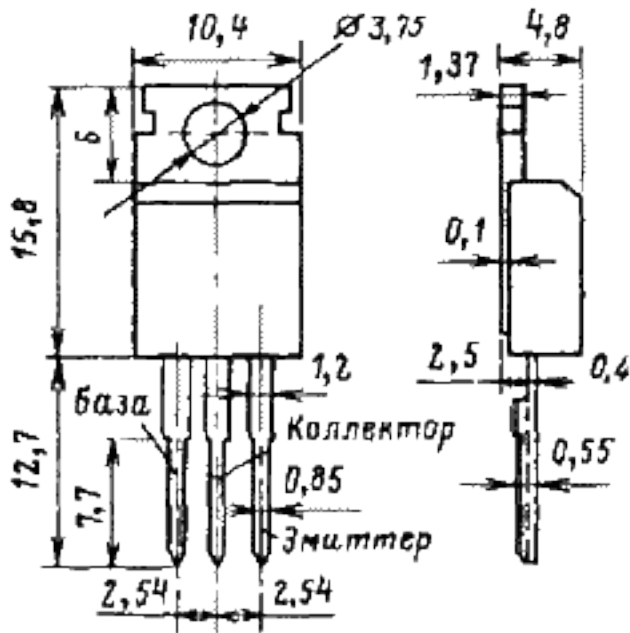


# КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г



Транзисторы кремниевые мезоплаиарные *n-p-n* составные универсальные низкочастотные мощные

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

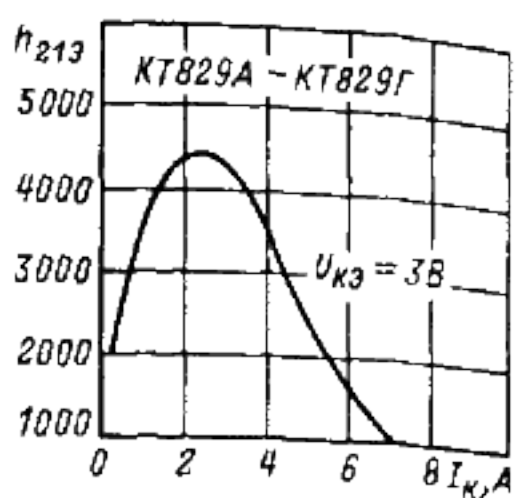
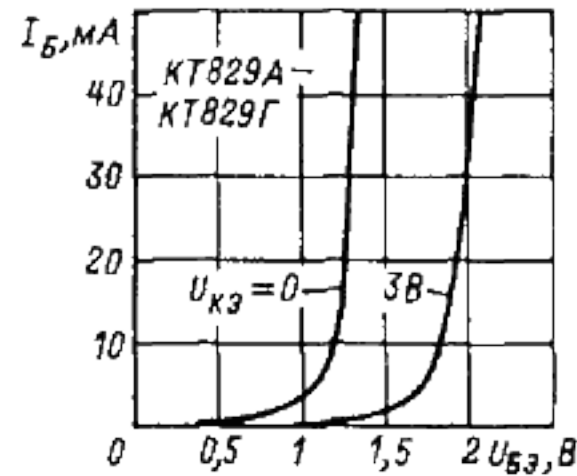
Масса транзистора не более 2 г

## Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_K = 100$ мА не менее:		
КТ829А . . . . .		100 В
КТ829Б . . . . .		80 В
КТ829В . . . . .		60 В
КТ829Г . . . . .		45 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 3,5$ А, $I_B = 14$ мА не более . . . . .		2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 3,5$ А, $I_B = 14$ мА не более . . . . .		2,5 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 3$ А не менее		
при $T_K = 298$ К и $T_K = 358$ К . . . . .		750
при $T_K = 233$ К . . . . .		100
Модуль коэффициента передачи тока при $f = 10$ МГц, $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 3$ А не менее . . . . .		0,4
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс}}$ $R_{БЭ} = 1$ кОм не более		
при $T_K = 298$ К и $T_K = 233$ К . . . . .		1,5 мА
при $T_K = 358$ К . . . . .		3 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В не более		2 мА

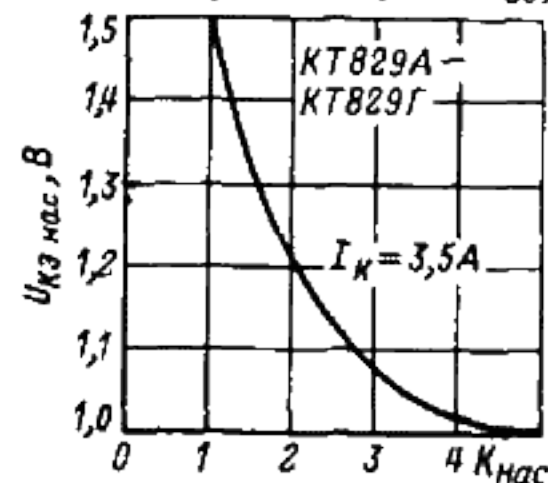
## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq$ $\leq 1$ кОм, постоянное напряжение коллектор-база		
КТ829А . . . . .		100 В
КТ829Б . . . . .		80 В
КТ829В . . . . .		60 В
КТ829Г . . . . .		45 В
Постоянное напряжение база-эмиттер . . . . .		5 В
Постоянный ток коллектора . . . . .		8 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_K \leq 500$ мкс, $Q \geq 10$ . . . . .		12 А
Постоянный ток базы . . . . .		0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K \leq 298$ К . . . . .		60 Вт

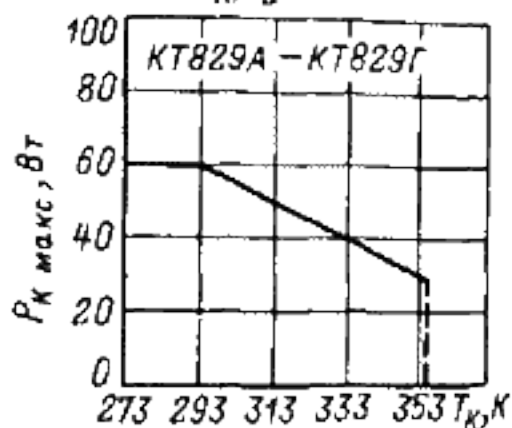
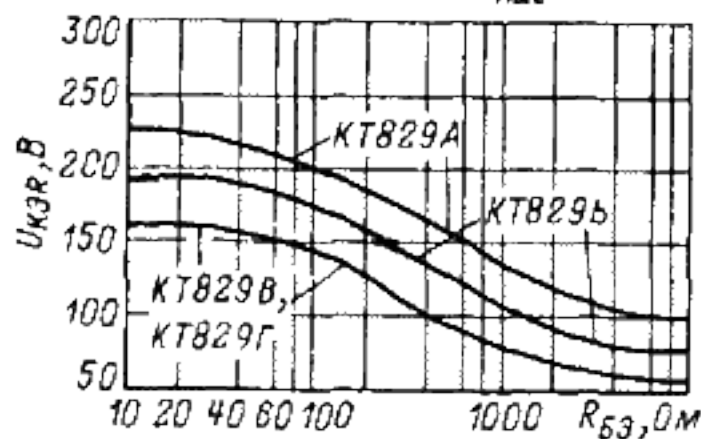


Входные характеристики

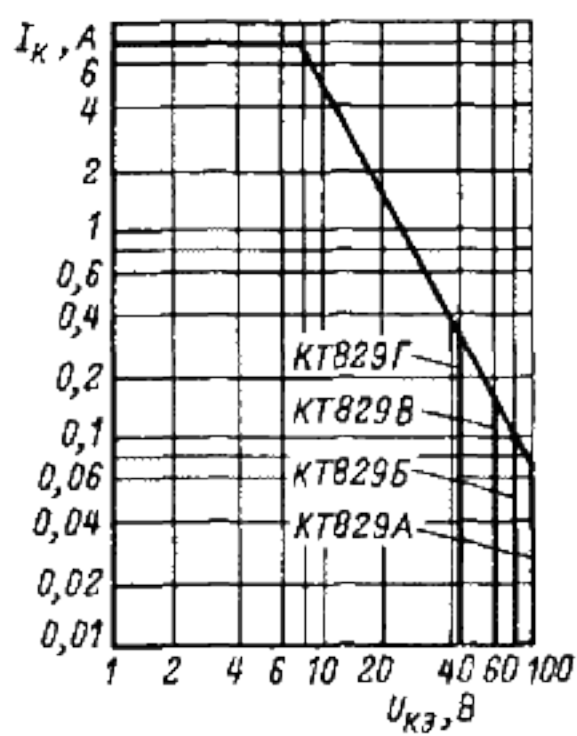
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от  $I_K/I_B$



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер



Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.

Область максимальных режимов